



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 6590—1998  
idt IEC 747-6-2:1991  
QC 750111

## 半导体器件 分立器件 第6部分：闸流晶体管 第二篇 100A 以下环境或管壳额定的 双向三极闸流晶体管空白详细规范

Semiconductor devices—Discrete devices  
Part 6: Thyristors  
Section Two—Blank detail specification for  
bidirectional triode thyristors (triacs),  
ambient or case-rated, up to 100A

1998-11-17 发布

1999-06-01 实施

国家质量技术监督局 发布

## **前　　言**

本规范等同采用 IEC 747-6-2:1991《半导体器件 分立器件 100A 以下环境或管壳额定的双向三极闸流晶体管空白详细规范》。本规范是国家标准 GB/T 6590—1986 的修订版。

本规范与 GB/T 6590—1986 的主要差别是：在第 4 章中增加了电流与温度的降额曲线；删去了 C2c 和 C2d 的分组号，该组的内容合并到 C2b 分组，并调整了引用总规范及分规范的标准号。

除非另有规定，本规范第 8 章中引用的条款号对应于 GB/T 4589.1—1989《半导体器件 分立器件和集成电路总规范》(IEC 747-10:1984)的条款号，测试方法引自 GB/T 15291—1994《半导体分立器件和集成电路 第 6 部分：闸流晶体管》(IEC 747-6:1991)；试验方法引自 GB/T 4937—1995《半导体器件机械和气候试验方法》(IEC 749:1984)。

本规范由中华人民共和国电子工业部提出。

本规范由全国半导体器件标准化技术委员会归口。

本规范由电子工业部标准化研究所负责起草。

本规范主要起草人：于志贤、杨志丹、顾康麟。

## IEC 前言

1) IEC(国际电工委员会)在技术问题上的正式决议或协议,是由对这些问题特别关切的国家委员会参加的技术委员会制定的,对所涉及的问题尽可能地代表了国际上的一致意见。

2) 这些决议或协议,以推荐标准的形式供国际上使用,并在此意义上为各国家委员会所认可。

3) 为了促进国际间的统一,IEC 希望各国家委员会在本国条件许可的情况下,采用 IEC 标准的文本作为其国家标准,IEC 标准与相应国家标准之间的差异,应尽可能在国家标准中指明。

本标准由 IEC 第 47 技术委员会(半导体器件)制定。

本标准是 100A 以下环境或管壳额定的双向三极闸流晶体管空白详细规范。

本标准文本以下列文件为依据:

六个月法	表决报告
47(CO)986	47(CO)1099

表决批准本标准的所有资料可在上表所列的表决报告中查阅。

本标准封面上的 QC 号是 IEC 电子元器件质量评定体系(IECQ)的规范号。

本标准中引用的其他 IEC 标准:

IEC 68-2-17:1978 基本环境试验程序,第 2 部分:试验,试验 Q:密封

IEC 191-2:1966 半导体器件的机械标准化,第 2 部分:尺寸(在修订中)

IEC 747-6:1983 半导体器件 分立器件 第 6 部分:闸流晶体管

IEC 747-10:1984 半导体器件 第 10 部分:分立器件和集成电路总规范

IEC 747-11:1985 半导体器件 第 11 部分:分立器件分规范

IEC 749:1984 半导体器件 机械和气候试验方法

中华人民共和国国家标准

半导体器件 分立器件

第6部分：闸流晶体管

第二篇 100A以下环境或管壳额定的  
双向三极闸流晶体管空白详细规范

Semiconductor devices—Discrete devices

Part 6: Thyristors

Section Two—Blank detail specification for  
bidirectional triode thyristors (triacs),  
ambient or case-rated, up to 100A

GB/T 6590—1998  
idt IEC 747-6-2:1991  
QC 750111  
代替 GB/T 6590-1986

## 引言

本空白详细规范规定了制定 100A 以下(含 100A)环境或管壳额定的双向三极闸流晶体管(包括快速型)详细规范的基本原则,制定该范围内的所有详细规范应尽可能与本空白详细规范相一致。

本空白详细规范是与 GB/T 4589.1—1989《半导体器件 分立器件和集成电路总规范》(IEC 747-10:1984)和 GB/T 12560—1990《半导体器件 分立器件分规范》(IEC 747-11:1985)有关的一系列空白详细规范中的一个。

## 要求资料

下列所要求的各项内容,应列入规定的相应的空栏内。

详细规范的识别:

- [1] 授权起草详细规范的国家标准机构的名称。
- [2] IECQ 详细规范号。
- [3] 总规范号和分规范号以及年代号。
- [4] 详细规范号、发布日期和国家体系要求的更多的资料。

器件的识别:

- [5] 器件型号。
- [6] 典型结构和应用资料。如果设计一种器件满足若干应用,则应在详细规范中指出。这些应用的特性、极限值和检验要求均应予以满足。如果器件对静电敏感,或含有害物质,例如氧化铍,则应在详细规范中附加注意事项。
- [7] 外形图和(或)引用有关的外形标准。
- [8] 质量评定类别。
- [9] 能在各器件型号之间比较的最重要特性的参考数据。  
[在方括号内给出的内容供指导规范制定者使用,而不包括在详细规范内。]  
[整个空白详细规范中,当特性或额定值适用时,×表示在详细规范中应填入的值。]